

## 5.8 Obvod IIL (I<sup>2</sup>L)

I integrated  
I injection  
L logic

**Definícia:** Jedná sa o integrovaný obvod so vstrekováním nosičov náboja zostavený z bipolárnych tranzistorov.

Základné parametre: - malý energetický ukazovateľ (1pJ)  
malá plocha základnej štruktúry hradla

čas prenosu 10ns

malá spotreba výkonu (200μW)

technika IIL umožňuje dosiahnuť veľkú hustotu osadenia prvkov – až 1000hradiel/mm<sup>2</sup>